

- 職務名称： レーザデバイス MBE エンジニア
- 配属部門： レーザデバイス事業部
- 募集理由： 当社重要技術である MBE 結晶成長技術を用いた開発・生産体制を強化するためにエンジニアの増員が必要であるため。
- 開始時期： 2022 年 6 月頃から就業可能な方
- 就業場所： 川崎市川崎区南渡田町 1-1 （南武支線浜川崎駅下車）
- 年齢： 20 歳代～40 歳代
- 想定年収： 500-800 万円
- 雇用形態： 正社員

■業務内容：

- ・分子線エピタキシー（MBE）装置稼働・メンテナンス
- ・ウェハ積層構造設計、評価、解析業務
- ・顧客からの問合せに対する対応
- ・国内外への顧客訪問・展示会参加

■スキル／経験：

【必須要件】

- ・大卒以上、かつ就業経験 1 年以上
- ・III-V 族化合物半導体（GaAs、InAs 等）についての知識、経験
- ・III-V 族化合物半導体の結晶成長の知識、経験
- ・III-V 族化合物半導体による発光素子（半導体レーザ、LED 等）の基礎知識

【歓迎条件】

- ・分子線エピタキシー（MBE）結晶成長装置の稼働、メンテナンス経験
- ・MBE 成長に関するメカニズム等の知識
- ・エピタキシャル積層構造設計、評価、解析についての経験・知識
- ・ビジネス英会話（目安：TOIEC 700 点以上）

【求める人物像】

- ・新しい技術に興味を持ち、自ら考え、自ら行動できる人
- ・グループの中のメンバーとして、チームワークを大切にしながらグループ全体としてのパワーを向上させることができる人
- ・開発、生産、営業メンバーと密な連携をとり、会社の目指すべき方向性を認識し、営業・生産・開発のより良いバランスを構築できる人
- ・強い意思を持って目標達成できる人

以上